

红外与毫米波学报

J. Infrared Millim. Waves

第十三卷年度索引

(一九九四年)

关键词索引

表面效应

——线性和非线性静磁表面波能流的受控偏转特性 (131)

波导

——线性和非线性静磁表面波能流的受控偏转特性 (131)

——金属包层平面光波导偏振器和在线单模光纤偏振器的理论和实验研究 (235)

——用双重场匹配法分析 GNRD 波导介质带间隙的不连续性 (299)

薄膜

——关于多量子阱光谱的部分相干模型计算 (328)

测温

——细分光谱高温线性拟合方案的研究 (436)

——接近灰体的短波辐射源色温修正为真温的近似法 (443)

超晶格

——硅基低维结构材料 (述评)(1)

——分子束外延生长晶格匹配 HgSe/ZnTe 超晶格 (53)

——超晶格 (CdTe-ZnTe)/ZnTe/GaAs(001) 红外材料的 X 射线测定 (59)

——HgTe/CdTe 超晶格的分子束外延生长和电容-电压谱研究 (73)

——超晶格电子辐照缺陷的亚稳态特性 (161)

弛豫时间

——碲镉汞导带电子回旋共振线性分析 (449)

成像光谱仪

——星载成像光谱仪星上实时数据压缩的研

究 (102)

磁光效应

——Si  $\delta$  掺杂 GaAs 多量子阱的磁量子输运 (37)

——局域在浅施主能级上的电子输运行为研究 (347)

地表

——自然环境下地表红外辐射特性对比研究 (418)

碲镉汞

——HgTe/CdTe 超晶格的分子束外延生长和电容-电压谱研究 (73)

——MOCVD-Hg<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>Te/CdTe/GaAs 外延材料红外吸收光谱研究 (191)

——p型Hg<sub>0.76</sub>Cd<sub>0.24</sub>Te的子能带结构 (199)

——碲镉汞导带电子回旋共振线性分析 (449)

——Hg<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>Te 深缺陷能级研究 (359)

——Hg<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>Te 的稳态光电导响应和瞬态响应分布研究 (352)

——局域在浅施主能级上的电子输运行为研究 (347)

——多元 HgCdTe 线列探测器的同步辐射形貌分析 (385)

电介质

——毫米波准光腔双层介质参数测量新技术 (285)

电容谱

——p型Hg<sub>0.76</sub>Cd<sub>0.24</sub>Te的子能带结构 (199)

多孔硅

——硅基低维结构材料 (述评)(1)

多普勒加宽

——多普勒加宽的斯塔克效应光学双稳性分

析 (207)

## 二维电子

—利用双势垒结构研究磁场下二维电子的态密度 (165)

## 分子束外延

—分子束外延生长晶格匹配 HgSe/ZnTe 超晶格 (53)

—HgTe/CdTe 超晶格的分子束外延生长和电容-电压谱研究 (73)

## 辐射

—光学系统中杂散辐射的分析 (455)

—细分光谱高温测温线性拟合方案的研究 (436)

—接近灰体的短波辐射源色温修正为真温的近似法 (443)

—多元 HgCdTe 线列探测器的同步辐射形貌术分析 (385)

## 高次边缘元

—一种新的高次边缘元方法 (251)

## 共振隧穿

—双量子阱结构中电子共振隧穿的相干模型 (333)

## 光电导

— $\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$  的稳态光电导响应和瞬态响应分布研究 (352)

## 光谱

—单膜光纤中膜耦合微扰功率谱与偏振关系的研究 (467)

—非量子限条件下 p 型 InSb MOS 结构反型层中子能带实验研究 (369)

—关于多量子阱光谱的部分相干模型计算 (328)

— $\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$  深缺陷能级研究 (359)

—GaAs/AlGaAs 多量子阱红外探测器的光电流谱 (15)

—GaAs/ $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$  多量子阱红外探测器的光调制光谱研究 (21)

—高电场下 InGaAs/InAlAs 宽量子阱中 11h 激子电透射谱的均匀和非均匀展宽 (27)

—GaAs/AlGaAs 非对称耦合双阱光荧光的温度依赖关系 (77)

—天然 PbS (方铅矿) 的远红外反射光谱 (81)

—Voigt 线型的微分消卷积 (140)

—氯化钠晶体色心近红外光谱精细结构 (153)

—CdTe/ $\text{Cd}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te}$ :In 应变层量子阱的光荧光光谱 (186)

—MOCVD- $\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$ /CdTe/GaAs

外延材料红外吸收光谱研究 (191)

—3 通道短波红外光谱可识别列阵探测器的研制 (401)

## 光纤

—单模光纤中模耦合微扰功率谱与偏振关系的研究 (467)

## 光学常数

—非均匀介质的光学常数 (391)

## 光学双稳性

—多普勒加宽的斯塔克效应光学双稳性分析 (207)

## 光学系统

—数学形态变换的光学实时实现及其应用 (321)

## 光学元件

—利用液晶光阀实现的光学形态变换 (124)

—用 Hopfield 网络实现二元串码滤波器 (221)

—金属包层型平面光波导偏振器和在线单模光纤偏振器的理论和实验研究 (235)

## 光折变

—半绝缘 GaAs:Cr 晶体  $1.06\ \mu\text{m}$  三波混合研究 (181)

—载流子浓度对光折变  $\text{LiNbO}_3$  晶体二波耦合增益的影响 (227)

— $\text{KNbO}_3:\text{Fe}$  二波耦合温度效应研究 (231)

## 光致发光

— $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{Al}_y\text{Ga}_{1-y}\text{As}$  多量子阱的高压光致发光研究 (45)

## 毫米波

—3mm 波段级近距离雷达 (256)

—毫米波雷达的高分辨力成像 (261)

—6 mm 介质稳频微带耿氏振荡器 (267)

—75~115 GHz 相位锁定固态源 (273)

—毫米波准光腔双层介质电介质参数测量新技术 (285)

—毫米波 HEMT 器件的电路模型研究 (289)

—真空微电子毫米波器件 (295)

—毫米波 E 面电路双工器的计算机辅助设计 (309)

—研究毫米波细胞生物效应的新装置 (313)

—数字鉴相稳频的 8 mm 固态源 (317)

—4 mm 宽带集成电路混频器的研制 (305)

## 红外成像

—硅化铂红外焦平面凝视成像系统光谱响应特性的研究 (405)

**红外辐射**

- 碳化钛-堇青石复相导电型陶瓷结构与红外辐射特性的研究 (89)
- 岩石的红外波段辐射特性研究 (425)
- 粒度对样品辐射特性影响的实验研究 (431)
- 自然环境下地表红外辐射特性对比研究 (418)

**回旋共振**

- 碲镉汞导带电子回旋共振线形分析 (449)

**集成电路**

- GaAs 高速集成电路内部动态特性直接电光采样检测 (396)

**激光器**

- 新型纵向快流一氧化碳激光器 (461)

**量子阱**

- GaAs/GaAlAs 量子阱红外探测器实用性探讨 (9)
- GaAs/GaAlAs 多量子阱红外探测器的光电流谱 (15)
- GaAs/Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>As 多量子阱红外探测器的光调制光谱研究 (21)
- 高电场下 InGaAs/InAlAs 宽量子阱中 11h 激子电透射谱的均匀和非均匀展宽 (27)
- MOCVD 生长 GaAs/Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>As 多量子阱子带间红外吸收特性 (33)
- Si δ 掺杂 GaAs 多量子阱的磁量子输运 (37)
- In<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>As/Al<sub>y</sub>Ga<sub>1-y</sub>As 多量子阱的高压光致发光研究 (45)
- GaAs/GaAlAs 单量子阱光调制器电学行为 (65)
- 量子阱中电子隧穿逃逸时间的研究 (69)
- GaAs/GaAlAs 非对称耦合双阱光荧光的温度依赖关系 (77)
- In<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>Te:In 应变层量子阱的光荧光光谱 (186)
- 新型电子器件和光学器件的共振隧穿结构 (特邀报告)(241)
- In<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>As/GaAs 应变量子阱光学性质 (340)
- 具有宽带响应的 GaAs/GaAlAs 多量子阱红外探测器 (377)
- 双量子阱结构中电子共振隧穿的相干模型 (333)

**滤光片**

- 用掩模分离法制备筒型红外滤光片阵列的工艺研究 (109)

**模式识别**

- 全双极 WTA 模型的改进及其实现 (213)
- 用 Hopfield 网络实现二元串码滤波器 (221)

**铌酸钾 (KNbO<sub>3</sub>)**

- KNbO:Fe 二波耦合温度效应研究 (231)

**耦合**

- 单模光纤中模耦合微扰功率谱与偏振关系的研究 (467)
- 载流子浓度对光折变 LiNbO<sub>3</sub> 晶体二波耦合增益的影响 (227)
- KNbO:Fe 二波耦合温度效应研究 (231)

**缺陷**

- 超晶格电子辐照缺陷的亚稳态特性 (161)
- Hg<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>Te 深缺陷能级研究 (359)
- 多元 HgCdTe 线列探测器的同步辐射形貌术分析 (385)
- 非量子限条件下 p 型 InSb MOS 结构反型层中子能带实验研究 (369)

**热辐射**

- PTR 技术中空间分辨率的频率特性 (145)

**热释电**

- 热释电探测器外部噪声的研究 (113)

**色散**

- 一种新的高次边元缘方法 (251)

**砷化钾**

- MOCVD 生长 GaAs/Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>As 多量子阱子带间红外吸收特性 (33)
- Si δ 掺杂 GaAs 多量子阱的磁量子输运 (37)
- 超晶格(CdTe-ZnTe)/ZnTe/GaAs(001) 红外材料的 X 射线测定 (59)
- GaAs/GaAlAs 单量子阱光调制器电学行为 (65)
- GaAs/AlGaAs 非对称耦合双阱光荧光的温度依赖关系 (77)
- Ga 和 GaAs 线膨胀系数和能隙的温度关系 (173)
- 半绝缘 GaAs:Cr 晶体 1.06 μm 三波混合研究 (181)
- In<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>As/GaAs 应变量子阱光学性质 (340)

**神经网络**

- IPA 模型对 Hopfield 模型神经网络的改进 (119)
- 全双极 WTA 模型的改进及其实现 (213)

- 用 Hopfield 网络实现二元串码滤波器 (221)
- 用 Kohonen 神经网络对高光谱分辨率图象进行无监督分类的研究 (409)
- 探测器**
  - GaAs/GaAlAs 量子阱红外探测器实用性探讨 (9)
  - GaAs/AlGaAs 多量子阱红外探测器的光电流谱 (15)
  - GaAs/Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>As 多量子阱红外探测器的光调制光谱研究 (21)
  - 热释电探测器外部噪声的研究 (113)
  - 9 μm p<sup>+</sup>-Ge<sub>x</sub>Si<sub>1-x</sub>/p-Si 异质结内光电红外探测器 (149)
  - 新型薄膜温差电堆红外探测器的研制 (157)
  - 新型电子器件和光学器件的共振隧穿结构 (特邀报告)(241)
- 多元 HgCdTe 线列探测器的同步辐射形貌分析 (385)
- 单片集成透镜高速 1×4 InGaAs/InP pin 探测器阵列研究 (364)
- 具有宽带响应的 GaAs/GaAlAs 多量子阱红外探测器 (377)
- 3 通道短波红外光谱可识别列阵探测器的研制 (401)
- 遥感**
  - 在海域红外杂波背景中小目标探测的空间匹配滤波技术 (95)
  - 星载成像光谱仪星上实时数据压缩的研究 (102)
- 折射率**
  - 低于 1000 GHz 电磁波的大气复折射率 (278)

## 作者索引

- 白长城——见张建奇 (418)
- 柏玲仙——见王 彪 (305)
- 鲍家善——见王 奇 (131)
- 边少平——见张洪喜 (227)
- 蔡 毅、郑国珍、汤定元 (中国科学院上海技术物理研究所), 朱惜辰(昆明物理研究所), 蒋建华 (中国科学院高能物理研究所): 多元 HgCdTe 线列探测器的同步辐射形貌分析(385)
- 蔡英时——见王 奇 (131)
- 曹金荣——见赵大德 (267)
- 程实平、张凤山、严义坝(中国科学院上海技术物理研究所): 用掩模分离法制备微型红外滤光片列阵的工艺研究(109)
- 程实平、严义坝、张凤山、许步云、朱翠媛(中国科学院上海技术物理研究所): 3 通道短波红外光谱可识别列阵探测器的研制(401)
- 程思远——见刘 坤 (199)
- 程兴奎(山东大学光电材料与器件研究所)、黄柏标、徐现刚、刘士文、任红文、蒋民华(山东大学晶体材料研究所): MOCVD 生长 GaAs/Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>As 多量子阱子带间红外吸收特性(33)
- 陈峰云——见靳新全 (381)
- 陈 晖、黄香馥、朱君范(电子科技大学微波测试中心): 毫米波 HEMT 器件的电路模型研究(289)
- 陈京——见钟福民 (59)
- 陈历学——见袁石夫 (124)
- 陈敏辉——见陆 卫 (9)
- 陈善怀、徐之材、杨桂攀(中科院紫金山天文台): 75~115 GHz 相位锁定固态源(273)
- 陈学良——见肖德元 (364)
- 崔承禹——见邓明德 (425)
- 崔万秋、朱小英、金德江、周 群 (武汉工业大学): 碳化钛-蓝青石复相导电型陶瓷结构与红外辐射特性的研究(89)
- 邓明德(国家地震局综合观测队)、崔承禹、支毅乔(中国科学院遥感应应用研究所)、耿乃光(国家地震局地球物理研究所): 岩石的红外波段辐射特性研究(425)
- 邓衍茂——见赵大德 (261)
- 杜永强——见靳新全 (381)
- 樊正芳、许小剑、赵 素(国家航天局第二研究院北京环境特性研究所): 毫米波雷达的高分辨率成像(261)
- 方家熊——见茅文英 (352)
- 方建兴、王定兴(苏州大学): Voigt 线型的微分消卷积(140)
- 方小平——见张建奇 (418)
- 方志良——见路明哲 (119)
- 方志良——见刘 颖 (221)
- 方志良——见张建明 (321)
- 封松林、周 洁、卢励吾(中国科学院半导体研

- 究所): 超晶格电子辐照缺陷的亚稳态特性 (161)
- 封松林——见周 洁 (65) (359)
- 耿乃光——见邓明德 (425)
- 顾洪恩(天津大学): 氯化钠晶体色心近红外光谱精细结构(153)
- 顾勇华——见陆 卫 (9)
- 郭少令——见郑国珍 (347)
- 郭少令——见韦亚一 (37)
- 郭文轩——见张孝霖 (95)
- 郭一平(中国科学院上海技术物理研究所)、B.C. Forste (Centre for Remote Sensing & GIS, and school of surveying, The University of New South Wales, Australia): 用 Kohonen 神经网络对高光谱分辨率图像进行无监督分类的研究(409)
- 韩和相——见刘振先 (45)
- 韩心志、吕 咏(哈尔滨工业大学): 光学系统中杂散辐射的分析(455)
- 郝文晖——见张孝霖 (95)
- 贺凤成、徐大雄、王 本(北京邮电大学): 热释电探测器外部噪声的研究(113)
- 何 进——见杨建荣 (191)
- 洪 晶——见袁石夫 (124)
- 胡大璋、周兆先(中国电波传播研究所青岛研究中心): 低于 1000 GHz 电磁波的大气复折射率(278)
- 胡际璜——见龚大卫 (149)
- 胡晓宁——见周 洁 (359)
- 胡志宏——见毛念新 (81)
- 黄柏标——见程兴奎 (83)
- 黄香馥——见陈 晖 (289)
- 黄醒良、沈文忠、陆 卫、穆耀明、沈学础(中国科学院上海技术物理研究所): GaAs/GaAlAs 多量子阱红外探测器的光电流谱 (15)
- 黄醒良——见陆 卫 (9)
- 黄肇明——见王 旭 (235)
- 贾 刚——见孙 伟 (396)
- 江德生——见徐士杰 (77)
- 江德生——见李 锋 (340)
- 蒋民华——见程兴奎 (33)
- 蒋建华——见蔡 毅 (385)
- 姜 山、张家明、沈学础(中国科学院上海技术物理研究所):  $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te}:\text{In}$  应变层量子阱的光荧光光谱(186)
- 姜 山——见杨立新 (21)
- 蒋 伟——见陆 卫 (9)
- 金德江——见崔万秋 (89)
- 金世荣、罗晋生(西安交通大学)、徐仲英(中国科学院半导体研究所): 双量子阱中电子共振隧穿的相干模型(333)
- 靳新全、王丽娟、彭秀哲、李国珍、杜永强、陈峰云(锦州师范学院): JS-2 红外涂料与 95 号玻璃复合体高热辐射强度的研究(381)
- 龚大卫、卢学坤、卫 星、扬小平、胡际璜、盛 麓、张翔九、王 迅(复旦大学)、周 涛、叶红娟、沈学础(中国科学院上海技术物理研究所):  $9\mu\text{m p}^+\text{-Ge}_x\text{Si}_{1-x}/\text{p-Si}$  异质结内光电红外探测器(149)
- 龚惠兴——见张 斧 (102)
- 孔梅影——见李晋闽 (377)
- 冷 静(华东船舶工业学院)、A. Dimoulas、K. Zekentes、M. Androulidaki (Foundation for Research and Technology-Hellas, Institute of Electronic Structure and Laser, P.O. Box 1527, Heraklion 71110, Crete, Greece): 高电场下 InGaAs/InAlAs 宽量子阱中 11h 激子电透射的均匀和非均匀展宽(27)
- 李承芳——见宁爱民 (165)
- 李 锋、张耀辉、江德生、王佑祥(中国科学院半导体研究所):  $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{GaAs}$  应变量子阱光学性质(340)
- 李国华——见刘振先 (45)
- 李国华——见徐士杰 (77)
- 李国珍——见靳新全 (381)
- 李 杰——见钟福民 (59)
- 李晋闽、郑海群、曾一平、孔梅影(中国科学院半导体研究所): 具有宽带响应的 GaAs/GaAlAs 多量子阱红外探测器(377)
- 李佩赞——见王 磊 (145)
- 李兴国、陶玉明、薛小青、钱元庆、许建中(南京理工大学毫米波光波近感技术研究所): 3 mm 波段极近距离雷达(256)
- 李言谨——见茅文英 (352)
- 李言谨——见周 洁 (359)
- 李月霞——见宋爱民 (165)
- 李 泳(成都气象学院): 接近灰体的短波辐射色温修正为真温的近似法(443)
- 梁昌洪——见夏 军 (285)
- 林镇材——见叶 华 (317)
- 刘福来——见路明哲 (119)
- 刘福来——见刘 颖 (221)
- 刘福来——见张建明 (321)
- 刘宏伟(电子科技大学)、I.C. Hunter (Department of Electrical Engineering, University of Bradford, West Yorkshire, BD7 1DP, United Kingdom): 毫米波 E 面电路双工器的计算机辅助设计(309)

- 刘 剑——见徐士杰 (77)
- 刘 健(青岛大学纺织服装学院)、张才根(中国科学院上海技术物理研究所): 粒度对样品辐射特性影响的实验研究(431)
- 刘 坤、褚君浩、程思远、汤定元(中国科学院上海技术物理研究所): p 型  $\text{Hg}_{0.76}\text{Cd}_{0.24}\text{Te}$  的子能带结构(199)
- 刘 坤——见邱岳明 (73)
- 刘 坤、褚君浩、欧海疆、汤定元(中国科学院上海技术物理研究所): 非量子限条件下 p 型  $\text{InSb}$  MOS 结构反型层中子能带实验研究(369)
- 刘普霖、陆 卫、陆晓峰、褚君浩、肖继荣、沈学础(中国科学院上海技术物理研究所)、Michael von Ortenberg (Humboldt Universität zu Berlin, Institut für Physik, Invalidenstrass 110, D-10115 Berlin, Germany): 碲镉汞导带电子回旋共振线形分析(449)
- 刘士文——见程兴奎 (33)
- 刘兴权——见陆 卫 (9)
- 刘兴权——见马朝晖 (328)
- 刘 颖、路明哲、张建明、方志良、刘福来、母国光(南开大学现代光学研究所): 用 Hopfield 网络实现二元串码滤波器(221)
- 刘 颖——见张建明 (321)
- 刘振先、李国华、韩和相、汪兆平(中国科学院半导体研究所):  $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{Al}_y\text{Ga}_{1-y}\text{As}$  多量子阱的高压光致发光研究(45)
- 刘志均、肖利苓、章文勋(东南大学): 用双重场匹配法分析 GNRD 波导介质带间隙的不连续性(299)
- 陆 栋、王利民(复旦大学物理系现代物理研究所): Ge 和 GaAs 线膨胀系数和能隙的温度的关系(173)
- 卢励吾——见周 洁 (65) (359)
- 卢励吾——见封松林 (161)
- 路明哲、方志良、刘福来、母国光(南开大学现代光学研究所)、战元龄(南开大学): IPA 模型对 Hopfield 模型神经网络的改进(119)
- 路明哲——见刘 颖 (221)
- 路明哲——见张建明 (321)
- 陆 卫、欧海江、陈敏辉、马朝晖、刘兴权、黄醒良、茅惠兵、蒋 伟、沈学础、顾勇华、叶礼斌(中国科学院上海技术物理研究所): GaAs/GaAlAs 量子阱红外探测器实用性探讨(9)
- 陆 卫——见杨立新 (21)
- 陆 卫——见黄醒良 (15)
- 陆 卫——见刘普霖 (449)
- 陆 卫——见马朝晖 (328)
- 陆晓峰——见刘普霖 (449)
- 卢学坤——见龚大卫 (149)
- 吕 咏——见韩心志 (455)
- 罗安湘——见毛念新 (81)
- 罗晋生——见金世荣 (333)
- 骆永健——见叶 华 (317)
- 罗桂祥——见叶 华 (317)
- 马可军——见杨建荣 (191)
- 马朝晖、陆 卫、刘兴权、茅惠兵、邱岳明、沈学础(中国科学院上海技术物理研究所): 关于多量子阱光主普的部分相干模型计算(328)
- 马朝晖——见陆 卫 (9)
- 马振昌——见孙 伟 (396)
- 麦泳贤——见周佐平 (467)
- 茅惠兵——见杨立新 (21)
- 茅惠兵——见陆 卫 (9)
- 茅惠兵——见马朝晖 (328)
- 毛念新、叶红娟、沈学础(中国科学院上海技术物理研究所)、胡志宏、罗安湘(南京大学): 天然 PbS (方铅矿) 的远红外反射光谱(81)
- 茅文英、褚君浩、李言谨、王子孟、方家熊(中国科学院上海技术物理研究所):  $\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$  的稳态光电导响应和瞬态响应分布研究(352)
- 母国光——见路明哲 (119)
- 母国光——见申金媛 (213)
- 母国光——见刘 颖 (221)
- 母国光——见张建明 (321)
- 穆耀明——见黄醒良 (15)
- 欧海疆——见陆 卫 (9)
- 欧海疆——见刘 坤 (369)
- 彭秀哲——见靳新全 (381)
- 彭正夫——见韦亚一 (37)
- 彭中灵、袁诗鑫(中国科学院上海技术物理研究所): 分子束外延生长晶格匹配  $\text{HgSe}/\text{ZnTe}$  超晶格(53)
- 钱元庆——见李兴国 (256)
- 强亮生——见张洪喜 (227)
- 秦洪桂——见赵大德 (261)
- 邱岳明、刘 坤、袁诗鑫(中国科学院上海技术物理研究所):  $\text{HgTe}/\text{CdTe}$  超晶格的分子束外延生长和电容-电压谱研究(73)
- 邱岳明——见马朝晖 (328)
- 任琮欣——见肖德元 (364)
- 任红文——见程兴奎 (33)
- 盛 簏——见龚大卫 (149)
- 沈 杰——见郑国珍 (347)
- 沈金熙——见郑国珍 (347)
- 申金媛、张延析、母国光(南开大学现代光学研

- 究所): 全双极 WTA 模型的改进及其实现 (213)
- 沈寿珍——见杨建荣 (191)
- 沈学础——见姜山 (186)
- 沈学础——见杨立新 (21)
- 沈学础——见毛念新 (81)
- 沈学础——见龚大卫 (149)
- 沈学础——见黄醒良 (15)
- 沈学础——见陆卫 (9)
- 沈学础——见刘普霖 (449)
- 沈学础——见马朝晖 (328)
- 沈文忠——见黄醒良 (15)
- 舒郁文——见张孝霖 (95)
- 司承才——见周洁 (359)
- 宋爱民、郑厚植、杨富华、李承芳(中国科学院半导体研究所): 利用双势垒结构研究磁场下二维电子的态密度(165)
- 孙建国——见孙伟 (396)
- 孙景兰——见周洁 (65)
- 孙铁国、周南生(西安电子科技大学微电子研究所): 新型薄膜温差电堆红外探测器的研制 (157)
- 孙万均——见张景文 (181)
- 孙伟、田小建、贾刚、孙建国、衣茂斌(吉林大学)、马振昌、王国全(电子工业部第二研究所): GaAs 高速集成电路内部动态特性直接电光采样检测(396)
- 孙秀冬——见张景文 (181)
- 汤炳谦——见赵大德 (261)
- 汤定元——见韦亚一 (37)
- 汤定元——见刘坤 (199) (369)
- 汤定元——见蔡毅 (385)
- 汤定元——见郑国珍 (347)
- 陶玉明——见李兴国 (256)
- 田小建——见孙伟 (396)
- 万作文(西南技术物理研究所)、朱大勇(电子科技大学光电子技术系): 多普勒加宽的斯塔克效应光学双稳性分析(207)
- 王宝明(天津医学院): 研究毫米波细胞生物效应的新装置(313)
- 王本——见贺凤成 (113)
- 王彪、周宝庆、柏玲仙(中科院上海技物所): 4 mm 宽带集成电路混频器的研制(305)
- 王德煌——见王威礼 (231)
- 王定兴——见方建兴 (140)
- 王国全——见孙伟 (396)
- 王建纬——见张健 (461)
- 王磊、李佩赞(苏州大学): PTR 技术中空间分辨率的频率特性(145)
- 王丽娟——见靳新全 (381)
- 王利民——见陆栋 (173)
- 王奇、鲍家善、蔡英时(上海科学技术大学)、A.D. Boardman (Department of Physics, Salford University Salford M54WT, UK): 现性和非线性静磁表面波能流的受控偏转特性(131)
- 王威礼、王德煌、郑英俊(北京大学物理系): KNbO<sub>3</sub>:Fe 二波耦合温度效应研究(231)
- 王旭、黄废明(上海科技大学)、朱红卫(上海交通大学)、F. Yan (Department of Physics, Columbia Univ., New York, N.Y. 10027, USA): 金属包层型平面光波导偏振器和在线单模光纤偏振器的理论和实验研究(235)
- 王迅——见龚大卫 (149)
- 王佑祥——见李锋 (340)
- 汪兆平——见刘振先 (45)
- 卫星——见龚大卫 (149)
- 韦亚一、郑国珍、郭少令、汤定元(中国科学院上海技术物理研究所)、彭正夫、张允强(南京电子器件研究所): Si  $\delta$  掺杂 GaAs 多量子阱的磁量子输运(37)
- 韦亚——见郑国珍 (347)
- 吴继友(山东大学): 细分光谱高温测温线性拟合方案的研究(436)
- 吴念乐——见张健 (461)
- 吴小平、周起勃(中国科学院上海技术物理研究所): 硅化铂红外焦平面凝视成像系统光谱响应特性的研究(405)
- 夏建白(中国科学院半导体研究所): 硅基低维结构材料(1)
- 夏军、梁昌洪(西安电子科技大学): 毫米波准光腔双层介质参数测量新技术(285)
- 肖德元、任琮欣、陈学良(中国科学院上海冶金研究所): 单片集成透镜高速  $1 \times 4$  InGaAs/InP pin 探测器阵列研究(364)
- 肖继荣——见刘普霖 (449)
- 肖克波——见周佐平 (467)
- 肖利苓——见刘志均 (299)
- 许步云——见程实平 (401)
- 徐崇泉——见张洪喜 (227)
- 徐大雄——见贺凤成 (113)
- 许建中——见李兴国 (256)
- 许克彬——见张景文 (181)
- 许克彬——见张洪喜 (227)
- 徐善驾、盛新庆(中国科学技术大学)、Masanori Koshiba (Dept. of Electronic Engineering, Jokkuido Univ., Sapporo, 060 Japan): 一种新的高次边缘元方法(251)
- 徐士杰、刘剑、李国华、郑厚植、江德生(中国科学院半导体研究所): GaAs/AlGaAs 非

- 对称耦合双阱光荧光的温度依赖关系(77)
- 徐文兰、褚君浩(中国科学院上海技术物理研究所): 非均匀介质的光学常数(391)
- 徐现刚——见程兴奎 (33)
- 许小剑——见樊正芳 (261)
- 徐亦庄——见张健 (461)
- 徐玉恒——见张洪喜 (227)
- 徐之材——见陈善怀 (273)
- 徐仲英——见金世荣 (333)
- 薛小青——见李兴国 (256)
- 严俊——见张孝霖 (95)
- 严义坝——见程实平 (109) (401)
- 杨富华——见宋爱民 (165)
- 杨桂攀——见陈善怀 (273)
- 杨建荣、何进、沈寿珍、马可军、俞振中(中国科学院上海技术物理研究所): MOCVD  $Hg_{1-x}Cd_xTe/CdTe/GaAs$  外延材料红外吸收光谱研究(191)
- 杨立新、姜山、茅惠兵、陆卫、沈学础(中国科学院上海技术物理研究所):  $GaAs/Al_xGa_{1-x}As$  多量子阱红外探测器的光调制光谱研究(21)
- 杨宜禾——见张建奇 (418)
- 杨小平——见龚大卫 (149)
- 衣茂斌——见孙伟 (396)
- 叶红娟——见龚大卫 (149)
- 叶红娟——见毛念新 (81)
- 叶华、骆永健、林镇材、罗桂祥(中山大学): 数字鉴相稳频的 8 mm 固态源(317)
- 叶礼斌——见陆卫 (9)
- 俞振中——见杨建荣 (191)
- 袁石夫、赵世杰、张学如、陈历学、洪晶(哈尔滨工业大学): 利用液晶光阀实现的光学形态变换(124)
- 袁诗鑫——见邱岳明 (73)
- 袁诗鑫——见钟福民 (59)
- 袁诗鑫——见彭中灵 (53)
- 曾一平——见李晋闽 (377)
- 战元龄——见路明哲 (119)
- 张才根——见刘健 (431)
- 张凤山——见程实平 (109) (401)
- 张海兴——见张建奇 (418)
- 张斧(上海机械学院上海先河光电公司)、龚惠兴、张智敏(中国科学院上海技术物理研究所): 星载成像光谱仪星上实时数据压缩的研究(102)
- 张洪喜、强亮生、徐崇泉、徐玉恒(哈尔滨工业大学应用化学系)、张景文、边少平、许克彬(哈尔滨工业大学应用物理系): 载流子浓度对光折变  $LiNbO_3$  晶体二波耦合增益的影响(227)
- 张家明——见姜山 (186)
- 张健、吴念乐、王建纬、赵钧、徐亦庄(清华大学): 新型纵向快流一氧化碳激光器(461)
- 张建明、路明哲、刘颖、方志良、刘福来、母国光(南开大学现代光学研究所): 数学形态变换的光学实时实现及其应用(321)
- 张建明——见刘颖 (221)
- 张建奇、方小平、张海兴、白长城、杨宜禾(西安电子科技大学): 自然环境下地表红外辐射特性对比研究(418)
- 张景文、赵桦、孙万钧、孙秀冬、许克彬(哈尔滨工业大学应用物理系): 半绝缘  $GaAs:Cr$  晶体  $1.06 \mu m$  三波混合研究(181)
- 张景文——见张洪喜 (227)
- 张闾辉——见赵大德 (261)
- 章文勋——见刘志均 (299)
- 张翔九——见龚大卫 (149)
- 张孝霖、郭文轩、舒郁文、郝文晖、严俊(华北光电所): 在海域红外杂波背景中小目标探测的空间匹配滤波技术(95)
- 张学如——见袁石夫 (124)
- 张延析——见申金媛 (213)
- 张耀辉——见李锋 (340)
- 张玉明、郑厚植(中国科学院半导体研究所): 量子阱中电子隧穿逃逸时间的研究(69)
- 张允强——见韦亚一 (37)
- 张智敏——见张斧 (102)
- 赵大德、曹金荣、邓衍茂、秦洪桂、汤柄谦、张闾辉(南京电子器件研究所): 6 mm 介质稳频微带耿氏振荡器(267)
- 赵桦——见张景文 (181)
- 赵钧——见张健 (461)
- 赵世杰——见袁石夫 (124)
- 赵素——见樊正芳 (261)
- 郑国珍、韦亚一、沈金熙、郭少令、沈杰、汤定元(中国科学院上海技术物理研究所): 局域在浅施主能级上的电子输运行为研究(347)
- 郑国珍——见韦亚一 (37)
- 郑国珍——见蔡毅 (385)
- 郑海群——见李晋闽 (377)
- 郑厚植——见徐士杰 (77)
- 郑厚植——见张玉民 (69)
- 郑厚植——见宋爱民 (165)
- 郑英俊——见邓明德 (231)
- 支毅乔——见邓明德 (425)
- 钟福民、陈京一、朱南昌(中国科学院上海冶金研究所)、李杰、袁诗鑫(中国科学院上海技术物理研究所): 超晶格 ( $CdTe-ZnTe$ )/ $ZnTe/GaAs(001)$  红外材料的 X 射线测定(59)



- 周宝庆——见王 彪 (305)
- 周 辉——见崔万秋 (89)
- 周 洁、封松林、卢励吾(中国科学院半导体研究所)、司承才、李言谨、胡晓宁(中国科学院上海技术物理研究所):  $Hg_{1-x}Cd_xTe$  深缺陷能级研究(359)
- 周南生——见孙铁圻 (157)
- 周起勃——见吴小平 (405)
- 周 涛——见龚大卫 (149)
- 周兆先——见胡大璋 (278)
- 周佐平、肖克波、麦泳贤(华南理工大学): 单模光纤中模耦合微扰功率谱与偏振关系的研究(467)
- 朱翠媛——见程实平 (401)
- 朱大勇——见万 文 (207)
- 朱红卫——见王 旭 (235)
- 朱君范——见陈 晖 (289)
- 褚君浩——见刘 坤 (199) (369)
- 褚君浩——见刘普霖 (449)
- 褚君浩——见徐文兰 (391)
- 褚君浩——见茅文英 (352)
- 朱南昌——见钟福民 (59)
- 朱小英——见崔万秋 (89)
- 朱惜辰——见蔡 毅 (385)
- 庄学曾(中国科学院电子学研究所): 真空微电子毫米波器件(295)
- M. Androulidaki——见冷 静 (27)
- A.D. Boardman——见王 奇 (131)
- A. Dimoulas——见冷 静 (27)
- B.C. Forste——见郭一平 (409)
- I.C. Hunter——见刘宏伟 (309)
- Michael von Ortenberg——见刘普霖 (449)
- C.J. Summers, Abbas Torabi (Quantum Microstructures Lab., Georgia Tech. Research Inst., Georgia Inst. of Tech., Atlanta, Georgia 30332, USA): 新型电子器件和光学器件的共振隧穿结构(241)
- Abbas Torabi——见 C.J. Summers (241)
- F. Yan——见王 旭 (235)
- K. Zekentes——见冷 静 (27)

## 机构索引

- 北京大学, 北京, 100871 (231)
- 北京北京邮电大学, 北京, 100088 (113)
- 成都气象学院, 四川, 成都, 610041 (443)
- 电子工业部第 13 研究所, 河北, 石家庄, 050051 (396)
- 电子科技大学, 四川, 成都, 610054 (207) (289)
- 东南大学, 江苏, 南京, 210018 (299)
- 复旦大学, 上海, 200433 (173) (149)
- 国家地震局地球物理研究所, 北京, 100081 (425)
- 国家地震局综合观测队, 北京, 100039 (425)
- 国家航天局第二研究院北京环境特性研究所, 北京, 100854 (261)
- 哈尔滨工业大学, 黑龙江, 哈尔滨, 150001 (181) (455)
- 华北光电技术研究所, 北京, 100015 (95)
- 华东船舶工业学院, 江苏, 镇江, 212003 (27)
- 华南理工大学, 广东, 广州, 510641 (467)
- 吉林大学, 吉林, 长春, 130023 (396)
- 锦州师范学院, 辽宁, 锦州, 121003 (381)
- 昆明物理研究所, 云南, 昆明, 650223 (385)
- 南京大学, 江苏, 南京, 210008 (81)
- 南京电子器件研究所, 江苏, 南京, 210016 (37) (267)
- 南京理工大学毫米波遥感技术研究所, 江苏, 南京, 210014 (256)
- 南开大学, 天津, 300071 (119)
- 南开大学现代光学所, 天津, 300071 (119) (213) (221) (321)
- 青岛大学纺织服装学院, 山东, 青岛, 266033 (431)
- 清华大学, 北京, 100084 (461)
- 山东大学, 山东, 济南, 250100 (33) (436)
- 上海机械学院, 上海, 200093 (102)
- 上海交通大学微电子研究所, 上海, 200030 (235)
- 上海科学技术大学, 上海, 201800 (131) (235)
- 苏州大学, 江苏, 苏州, 215006 (140) (145)
- 天津大学, 天津, 300072 (153)
- 天津医学院, 天津, 300070 (313)
- 武汉工业大学, 湖北, 武汉, 430070 (89)
- 西安电子科技大学, 陕西, 西安, 710071 (157) (285) (418)
- 西安技术物理研究所, 四川, 成都, 610041 (207)
- 西安交通大学, 陕西, 西安, 710049 (333)
- 中国电波传播研究所青岛研究中心, 山东, 青岛, 266003 (278)
- 中国科学技术大学, 安徽, 合肥, 230026 (251)
- 中国科学院半导体研究所, 北京, 100083 (1)

- (45) (65) (69) (77) (161) (165) (333) (340)  
(359) (377)
- 中国科学院电子学研究所, 北京, 100080 (295)
- 中国科学院高能物理研究所, 北京, 100039 (385)
- 中国科学院上海技术物理研究所, 上海, 200083  
(9) (15) (37) (53) (59) (73) (81) (102)  
(109) (149) (186) (191) (199) (305) (329)  
(347) (352) (359) (369) (385) (391) (401)  
(405) (409) (431) (449)
- 中国科学院上海冶金研究所, 上海, 200050 (59)  
(364)
- 中国科学院遥感应用研究所, 北京, 100101 (425)
- 中国科学院紫金山天文台, 江苏, 南京, 210008  
(273)
- 中山大学, 广东, 广州, 510275 (317)
- Department of Electrical Engineering, Univ.  
of Bradford, Yorkshire, BD71DP, United  
Kingdom (309)
- Department of Electronic Engineering, Hok-  
kaido University, Sapporo, 060 Japan  
(251)
- Department of Physics, Columbia University,  
N.Y. 10027, U.S.A. (235)
- Department of Physics, Salford University,  
Salford M54WT, UK (131)
- Foundation for Research and Technology-  
Hellas, Institute of Electronic Structure  
and Laser, P.O. Box 1427, Heraklion  
71110, Crete, Greece (27)
- Humboldt Universität zu Berlin, Institut für  
Physik, Invalidenstrass 110, D10115 Ber-  
lin, Germany (449)
- Quantum Microstructures laboratory, Geor-  
gia Tech Research Institute, Georgia In-  
stitute of Technology, Georgia 30332,  
USA (241)